

PNP 中功率放大三極管  
Medium Power Transistor(PNP)

Medium Power Transistor(PNP)

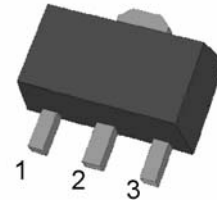
PNP 中功率放大三極管

FHB1132

DESCRIPTION & FEATURES 概述及特點

- 1) Low  $V_{CE(sat)} = -0.2V(Typ)$   
( $I_C / I_B = -500mA/-50mA$ )
- 2) Complements the FHD1664
- 3) Epitaxial planar type,  
PNP silicon transistor

SOT-89



PIN ASSIGNMENT 引腳說明

PIN NAME 管腳符號	PIN NUMBER 引腳序號	FUNCTION 功能
	SOT-89	
B	1	BASE
C	2	COLLECTOR
E	3	EMITTER

MAXIMUM RATINGS( $T_a=25^\circ C$ ) 最大額定值

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	$V_{CEO}$	-32	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	$V_{CBO}$	-40	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	$V_{EBO}$	-5	Vdc
Collector Current(DC)集電極電流-直流	$I_C$	-1	Adc
Collector Current(Pulse)集電極電流-脈衝	$I_{CP}$	-2	Adc

THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	$P_c$	500	mW
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	$T_J$ $T_{stg}$	150 , -55 ~150	$^\circ C$

DEVICE MARKING 打標

FHB1132P=BAP(82~180) , FHB1132Q=BAQ(120~270) , FHB1132R=BAR(180~390)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_a=25^\circ C$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^\circ C$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-1.0mA$	-32	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-50\mu A$	-40	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-50\mu A$	-5.0	—	—	V
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-20V$	—	—	-500	nA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-4V$	—	—	-500	nA
DC Current Gain 直流電流增益	$h_{FE}$	$V_{CE}=-3V, I_C=-100mA$	82	—	390	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$	—	-0.2	-0.5	V
Transition Frequency 特徵頻率	$f_T$	$V_{CE}=-5V, I_E=-50mA,$ $f = 30 MHz$	—	150	—	MHz
Collect Output Capacitance 輸出電容	$C_{Ob}$	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	—	20	30	pF